【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2005-507015(P2005-507015A)
【公表日】平成17年3月10日(2005.3.10)
【年通号数】公開・登録公報2005-010
【出願番号】特願2003-538232(P2003-538232)
【国際特許分類】
Ｃ０８Ｇ　77/16　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/312　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｇ　77/16
Ｈ０１Ｌ　21/312　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成17年5月27日(2005.5.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
樹脂のケイ素含有単位の全体量を基準として、5から50モル％の$(PhSiO_{(3-x)/2}(OH)_x)$単位および50から95モル％の$(HSiO_{(3-x)/2}(OH)_x)$単位(ただし、Phはフェニル基であり、xは、0、1または2の値を有する)を含むシリコーン樹脂。
【請求項２】
(I)樹脂のケイ素含有単位の全体量を基準として、5から50モル％の$(PhSiO_{(3-x)/2}(OH)_x)$単位および50から95モル％の$(HSiO_{(3-x)/2}(OH)_x)$単位(ただし、Phはフェニル基であり、xは、0、1または2の値を有する)を含むシリコーン樹脂と、
(II)40から99.5重量％[(I)および(II)の重量を基準とする]の溶媒を含む溶液。
【請求項３】
少なくとも30ダイン/cmの臨界表面自由エネルギーを有するフェニル化酸化物誘電体。
【請求項４】
フェニル化酸化物誘電体を製造する方法であって
(I)樹脂のケイ素含有単位の全体量を基準として、5から50モル％の$(PhSiO_{(3-x)/2}(OH)_x)$単位および50から95モル％の$(HSiO_{(3-x)/2}(OH)_x)$単位(ただし、Phはフェニル基であり、xは、0、1または2の値を有する)を含むシリコーン樹脂を基板に塗布する工程と、
(II)前記塗布済み基板を100℃から450℃の範囲の温度に加熱し、前記シリコーン樹脂を硬化させる工程を含む方法。
【請求項５】
誘電体材料を含む集積回路であって、前記誘電体材料が、
(A)少なくとも40ダイン/cmの臨界表面自由エネルギーを有する少なくとも1つの有機誘電体層と、
(B)少なくとも30ダイン/cmの臨界表面自由エネルギーを有する少なくとも1つのフェニル化酸化物誘電体層を含む集積回路。